



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**HBU3150A**

对应国外型号  
BU3150

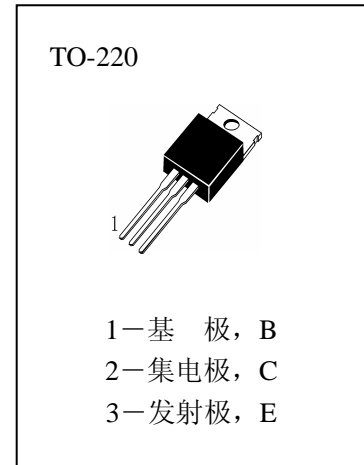
## ■ 主要用途

电子镇流器、节能灯、充电器及各类功率开关电路。

## ■ 极限值 ( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )

$T_{\text{stg}}$	——贮存温度	.....	$-65\sim 150^{\circ}\text{C}$
$T_j$	——结温	.....	$150^{\circ}\text{C}$
$P_C$	——集电极耗散功率 ( $T_c=25^{\circ}\text{C}$ )	.....	40W
$V_{\text{CBO}}$	——集电极—基极电压	.....	1000V
$V_{\text{CEO}}$	——集电极—发射极电压	.....	530V
$V_{\text{EBO}}$	——发射极—基极电压	.....	9V
$I_C$	——集电极电流 (DC)	.....	1.5A
$I_C$	——集电极电流 (脉冲)	.....	3A

## ■ 外形图及引脚排列



## ■ 电参数 ( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ )

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
$BV_{\text{CBO}}$	集电极—基极击穿电压	1000			V	$I_C=1\text{mA}$ , $I_E=0$
$BV_{\text{CEO}}$	集电极—发射极击穿电压	530			V	$I_C=5\text{mA}$ , $I_B=0$
$BV_{\text{EBO}}$	发射极—基极击穿电压	9			V	$I_E=1\text{mA}$ , $I_C=0$
$I_{\text{CEO}}$	集电极—发射极截止电流			100	$\mu\text{A}$	$V_{\text{CE}}=500\text{V}$ , $I_B=0$
$I_{\text{CES}}$	集电极—发射极截止电流			10	$\mu\text{A}$	$V_{\text{CB}}=920\text{V}$ , $I_E=0$
$I_{\text{EBO}}$	发射极—基极截止电流			10	$\mu\text{A}$	$V_{\text{EB}}=9\text{V}$ , $I_C=0$
$H_{\text{FE}}$	直流电流增益	12				$V_{\text{CE}}=10\text{V}$ , $I_C=1\text{mA}$
		15		40		$V_{\text{CE}}=10\text{V}$ , $I_C=0.4\text{A}$
		6				$V_{\text{CE}}=10\text{V}$ , $I_C=1\text{A}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压			1	V	$I_C=1\text{A}$ , $I_B=0.25\text{A}$
$V_{\text{BE(sat)}}$	基极—发射极饱和电压			1.4	V	$I_C=1\text{A}$ , $I_B=0.25\text{A}$
$t_{\text{STG}}$	贮存时间	2		6	$\mu\text{S}$	$V_{\text{CC}}=5\text{V}$ , $I_C=0.5\text{A}$ (UI9600)



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

**HBU3150A**

对应国外型号  
BU3150

## 特性曲线

Figure 1. Static Characteristics

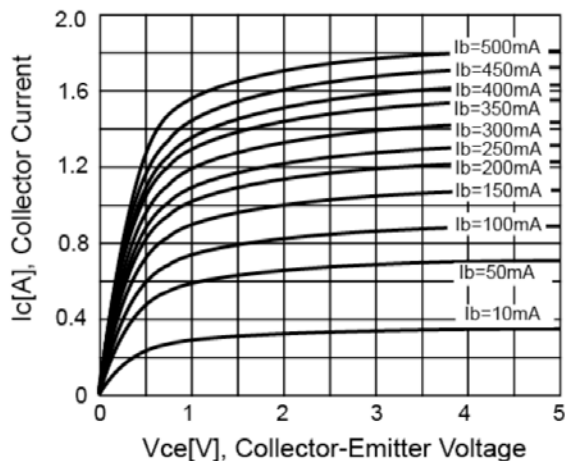


Figure 2. DC Current Gain

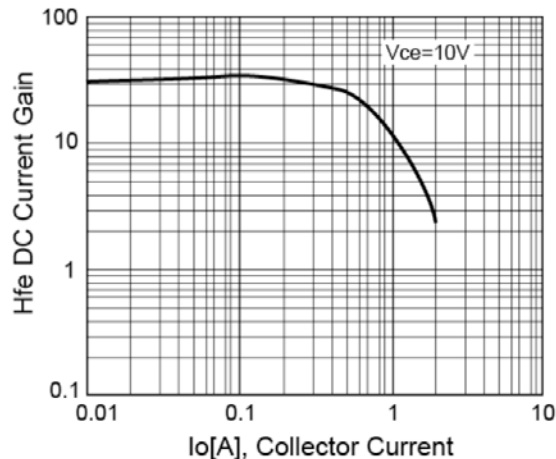


Figure 3.  $V_{CE(SAT)}$  V.S.  $V_{BE(SAT)}$

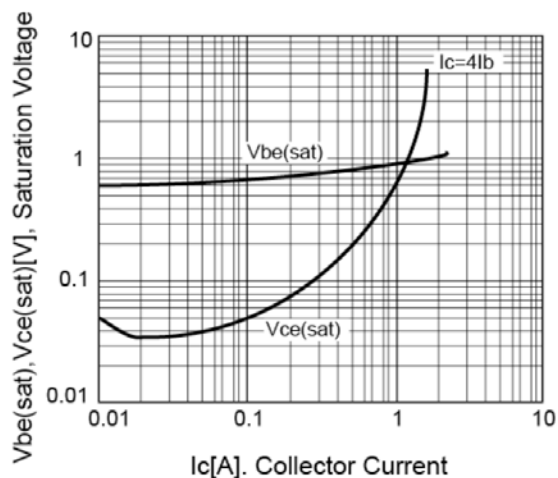


Figure 4. Power Derating

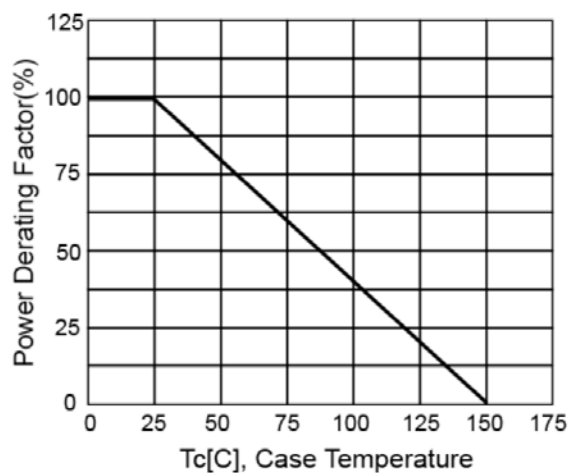


Figure 5. Reverse Bias SOA

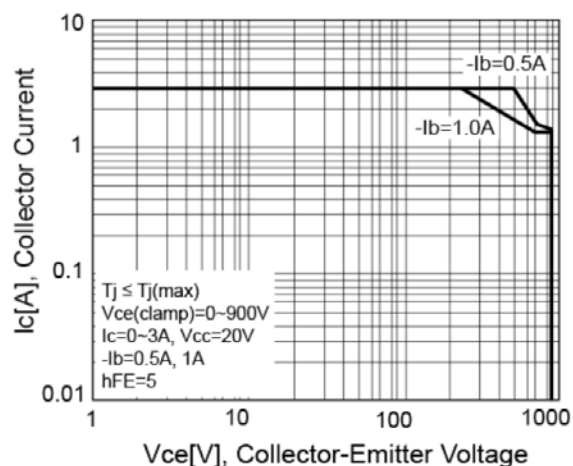


Figure 6. Safety Operating Area

